



SLS SEMICONDUCTOR (SHENZHEN) CO.,LTD.

SOT-23 封装半导体晶体管/SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors

MMBT5551 (NPN)

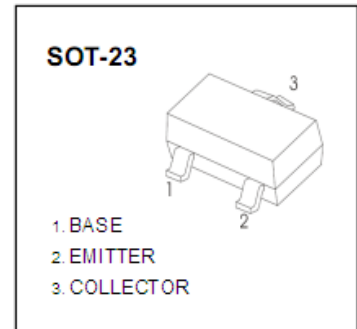
印章/Marking : G1

特点/Features :

击穿电压高 ;

用途/Applications :

用于普通高压放大 , 与 MMBT5401 互补。



极限参数/Absolute maximum ratings(Ta=25°C)

参数/Parameter	符号/ Symbol	数值/Value	单位/Unit
集电极-基极电压/Collector-Base Voltage	V_{CB0}	180	V
集电极-发射极电压/Collector-Emitter Voltage	V_{CE0}	160	V
发射极-基极电压/Emitter-Base Voltage	V_{EB0}	6	V
集电极连续电流/Collector Current Continuous	I_C	0.6	A
集电极耗散功率/Collector Power Dissipation	P_C	0.3	W
结温/Junction Temperature	T_j	150	°C
储存温度/Storage Temperature	T_{stg}	-55~150	°C

电性能参数/Electrical characteristics (Ta=25°C)

参数	符号	测试条件	最小值	最大值	单位
集电极-基极击穿电压	$V_{BR(CB0)}$	$I_C=100 \mu A, I_E=0$	180		V
集电极-发射极击穿电压	$V_{BR(CE0)}$	$I_C=1mA, I_B=0$	160		V
发射极-基极击穿电压	$V_{BR(EB0)}$	$I_E=10 \mu A, I_C=0$	6		V
集电极截止电流	I_{CB0}	$V_{CB}=120V, I_E=0$		0.1	μA
发射极截止电流	I_{EB0}	$V_{EB}=4V, I_C=0$		0.1	μA
直流电流增益	$h_{FE(1)}^*$	$V_{CE}=5V, I_C=1mA$	80		
直流电流增益	$h_{FE(2)}^*$	$V_{CE}=5V, I_C=10mA$	100	300	
直流电流增益	$h_{FE(3)}^*$	$V_{CE}=5V, I_C=50mA$	50		
集电极-发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}^*$	$I_C=10mA, I_B=1mA$		0.15	V
集电极-发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}^*$	$I_C=50mA, I_B=5mA$		0.2	V
基极-发射极饱和压降	$V_{BE(sat)}^*$	$I_C=10mA, I_B=1mA$		1	V
基极-发射极饱和压降	$V_{BE(sat)}^*$	$I_C=50mA, I_B=5mA$		1	V
特征频率	f_T	$V_{CE}=10V, I_C=10mA, f=100MHz$	100	300	MHz
输出电容	C_{OB}	$V_{CB}=10V, I_E=0, f=1MHz$		6	pF
输入电容	C_{IB}	$V_{BE}=0.5V, I_C=0, f=1MHz$		20	pF

*pulse test



典型特性曲线图/Typical Characteristics

